

日本材料学会半導体エレクトロニクス部門委員会
平成 22 年度第 1 回研究会

平成 22 年 5 月 8 日 (土) 13:30-17:20
大阪大学吹田キャンパス R1 棟 311 講義室
〒565-0871 吹田市山田丘 2-1

プログラム

13:30-13:50 **A01**

ガラス基板上へのイオン感応性酸化亜鉛トランジスターの作製と評価

辻久美穂、野上隆弘、小池一步、尾形健一、佐々誠彦、井上正崇、矢野満明

大阪工業大学 ナノ材料マイクロデバイス研究センター

13:50-14:10 **A02**

分極機能型強誘電体ゲート TFT のデバイス特性評価

福島匡泰、吉村武、前田和弘、芦田淳、藤村紀文

大阪府立大学工学研究科

14:10-14:30 **A03**

ZnO ナノロッドへの酵素固定化とグルコースセンシング

大阪工業大学 ナノ材料マイクロデバイス研究センター

○土橋秀章、尾形健一、小池一步、前元利彦、佐々誠彦、矢野満明、井上正崇

14:30-14:50 **A04**

常圧有機金属気相エピタキシャル法による Eu 添加 GaN の作製と LED 特性の改善

古川直樹、西川敦、川崎隆志、寺井慶和、藤原康文

大阪大学工学研究科

14:50-15:00 休憩

15:00-15:40 **B01**

強誘電体薄膜研究を巡って(特別講演)

奥山雅則

大阪大学ナノサイエンスデザイン教育研究センター

15:40-16:00 **C01**

GaAs 基板上にエピタキシャル成長した InAs 薄膜からの THz 波放射特性

石橋祐太郎¹、竹家啓²、前元利彦¹、佐々誠彦¹、井上正崇¹、斗内政吉²

¹大阪工業大学ナノ材料マイクロデバイス研、²大阪大学レーザーエネルギー研)

16:00-16:20 **C02**

InAs 量子ドットを利用した広帯域光源の開発

津田 恵実、井上 知也、喜多 隆

神戸大学工学研究科

16:20-16:40 **C03**

高 Al 組成 AlGa_N/AlN 量子井戸の Mott 転移付近のキャリアダイナミクス

大音隆男、岩田佳也、金田昭男、Ryan. G. Banal、船戸充、川上養一

京都大学工学研究科

16:40-17:00 **C04**

Si デバイスの熱特性を向上させる Si-on-SiC 基板の検討

木下博之、清水秀雄、篠原 広、吉本昌広

京都工芸繊維大学工芸科学研究科

17:00-17:20 **C05**

6H-SiC(0001)基板上 2H-AlN ヘテロポリタイプエピタキシャル成長層の欠陥制御

奥村宏典、木本恒暢、須田淳

京都大学大学院工学研究科